

信頼性試験結果 Reliability Test Result	Package(Type) TSMT5	ローム株式会社 トランジスタ・ダイオード ユニット ROHM CO., LTD. Transistor/Diode Unit
	品名(Product) MOS FET (Pb Free)	
作成日(Date) : 2/Feb/2010		

1. 試験結果(TEST RESULT)

試験項目 (TEST ITEM)	試験条件 (TEST CONDITION)	準拠規格 (STANDARD)	n[pcs] (Sample QTY.)	Pn[pcs] (NG QTY.)
はんだ耐熱性 Soldering heat resistance	260±5°C, 10秒, リフロー方式 2回	EIAJ ED-4701/300 Test Method 301	22	0
	260±5°C, 10sec., Reflow method 2times			
	260±5°C, 10秒, はんだ槽			
	260±5°C, 10sec., Solder-bath			
はんだ付け性 Solderability	350±10°C, 3秒, 手付け	-	22	0
	350±10°C, 3sec., Hand soldering			
はんだ付け性 Solderability	245±5°C, 3秒, リフロー方式	-	22	0
	245±5°C, 3sec., Reflow method			
	245±5°C, 3秒, はんだ槽			
温度サイクル Temperature cycle	245±5°C, 3sec., Solder-bath	EIAJ ED-4701/300 Test Method 303	22	0
	-55±5°C←→150±5°C 200サイクル	EIAJ ED-4701/100 Test Method 105	22	0
高温高湿逆バイアス High temp. high humidity reverse bias	-55±5°C←→150±5°C 200cycles	EIAJ ED-4701/100 Test Method 102	22	0
	85±2°C, 85±5%RH, 規定のバイアス, 1000時間			
飽和蒸気加圧 PCT Pressure cooker test	85±2°C, 85±5%RH, specified bias, 1000hours	JESD22-A102C	22	0
	121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100時間			
高温逆バイアス High temperature reverse bias	121±2°C, 100%RH, 203kPa, 100hours	EIAJ ED-4701/100 Test Method 101	22	0
	Ta=Tstg max, 規定のバイアス, 1000時間			
高温保存 High temperature storage	Ta=Tstg max., specified bias, 1000hours	EIAJ ED-4701/200 Test Method 201	22	0
	Tstg max., 1000時間			
低温保存 Low temperature storage	Tstg max., 1000hours	EIAJ ED-4701/200 Test Method 202	22	0
	Tstg min., 1000時間			
端子強度(引っ張り) Lead strength (lead pull)	Tstg min., 1000hours	EIAJ ED-4701/400 Test Method 401	22	0
	製品固定状態で軸方向荷重2.5N, 10±1sec保持.			
負荷寿命 Load Life	Sample body fixed, pulling lead axis direction, 2.5N, 10±1sec.	-	22	0
	25°C, P _D =P _D max. 1000時間			
熱衝撃 Thermal shock	25°C, P _D =P _D max 1000hours	-	22	0
	0°C ~ 100°C, 100サイクル			
	0°C ~ 100°C, 100cycles			

2. 測定項目及び故障判定基準(FAILURE CRITERIA)

測定項目 (ITEM)	測定条件 (CONDITION)	故障判定基準 (CRITERIA)	
MOS ゲート漏れ電流 : IGSS Gate-Source Leakage : IGSS ドレイン遮断電流 : IDSS Zero Gate Voltage Drain Current : IDSS 順電圧アドミタンス : Y _{fs} Forward Transfer Admittance : Y _{fs}	仕様書条件による Par specification	規格値の2倍以内 Within the two times of the standard value.	
		仕様書条件による Par specification	規格値の2倍以内 Within the two times of the standard value.
	仕様書条件による Par specification		初期値に対する変化率 ±20% Changing rate of ±20%
		DI 順方向電圧 : VF Forward voltage : VF 逆方向電流 : IR Reverse current : IR	仕様書条件による Per specification
仕様書条件による Par specification	初期値に対する変化率 ±20% Changing rate of ±20%		
仕様書条件による Par specification	初期値に対する変化率 ±20% Changing rate of ±20%		
共通 外観 Physical はんだ付け性 Solderability	目視 Visual check	著しい変化のないこと No outstanding change in physical.	
	目視 Visual check	リフロー方式 Reflow method	不濡れ(ランクC) 無きこと Non-wetting (rank C) unseen.
		はんだ槽 Solder-bath	電極部の95%以上がはんだで覆われていること More than 95% of the electrode must be covered with solder.

3. 判定結果(JUDGEMENT)

各試験項目とも不具合の発生は認められておりません。
No failure is observed from each test item.